

	<p>SI5511DC-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5511DC-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8</p> <p>Datenblätter:  SI5511DC-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 9000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI5511DC-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	9000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	55 mOhm @ 4.8A, 4.5V
Leistung - max	3.1W, 2.6W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	SI5511DC-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	435pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.1nC @ 5V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 30V 4A, 3.6A 3.1W, 2.6W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A, 3.6A
Basisteilenummer	SI5511

SI5511DC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5511DC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5511DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5511DC-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5509DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8</p>	 <p>SI5509DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8</p>	 <p>SI5511DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5513CDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8</p>
 <p>SI5511DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5511DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5509DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8</p>	 <p>SI5509DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8</p>

SI5511DC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5511DC-T1-E3 Datenblatt	SI5511DC-T1-E3-Datenblätter	SI5511DC-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5511DC-T1-E3
SI5511DC-T1-E3 Electronic	SI5511DC-T1-E3-Komponenten	SI5511DC-T1-E3-Verteiler	SI5511DC-T1-E3-Bild	SI5511DC-T1-E3-Aktie	SI5511DC-T1-E3-Teil
SI5511DC-T1-E3 Preis	SI5511DC-T1-E3 Hersteller	SI5511DC-T1-E3 garantiert	SI5511DC-T1-E3 RFQ	SI5511DC-T1-E3 Inventar	SI5511DC-T1-E3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited